

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 2月 6日
Date of Application:

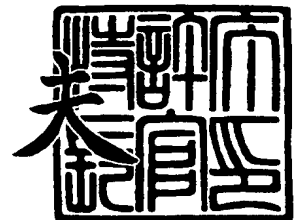
出願番号 特願2003-029956
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-029956]

出願人 株式会社半導体エネルギー研究所
Applicant(s):

2003年12月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 P006959

【提出日】 平成15年 2月 6日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 山崎 舜平

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置の作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する第 1 の液滴噴射装置を用いて、被処理膜上に導電性粒子を含有する液滴を噴射し、局所的に導電性膜を形成した後、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する第 2 の液滴噴射装置を用いて前記導電性膜の上に局所的にレジストパターンを形成し、前記レジストパターンをマスクとして前記導電性膜をエッチングし、配線を形成することを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 2】

請求項 1 の表示装置の作製方法において、前記導電性膜のエッチングは、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力で、局所的に行うことを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 の表示装置の作製方法において、前記導電性膜をエッチング後、前記レジスト膜を、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力で、局所的にエッチングすることを特徴とする表示装置の作製方法。

【請求項 4】

被処理基板上に導電性膜を形成した後、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力で、前記導電膜の不要な部分を局所的にエッチングし、配線を形成することを特徴とする表示装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置（LCD）に代表される表示装置の作製方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、液晶表示装置（LCD）や自発光表示装置（EL：エレクトロ・ルミネッセンス）表示装置）に代表される表示装置に含まれる薄膜トランジスタ（TFT）の作製には、処理装置の内部を減圧或いは真空状態で行う真空プロセスや、露光装置により（フォトリソグラフィ）レジストからなるマスクを作製し不要部をエッチング除去するフォトリソグラフィプロセスが用いられてきた。

【0003】

真空プロセスにおいては、被処理基板を成膜、エッチング等の処理を行うプロセスチャンバを、真空或いは減圧するための排気手段が必要となる。排気手段は処理装置外部に設置された、ターボ分子ポンプやロータリーポンプ等に代表されるポンプと、それらを管理、制御する手段、またポンプと処理室とを連結させて排気系を構成する配管やバルブ等で構成される。これら設備を整えるには、処理装置外に排気系のためのスペースが必要となり、またそのためのコストが必要となる。さらに処理装置自体にも排気系の設備を取り付ける必要があることから、処理装置のサイズが排気系を搭載しないものに比べ増大する。

【0004】

従来用いられてきた、薄膜トランジスタ等の配線形成のためのフォトリソグラフィプロセスは以下のように行う。まず感光性のレジスト（フォトリソレジスト）を基板上に成膜された導電性膜上にスピン塗布することで、導電性膜全面に前記レジストを広げる。次にメタルによってパターンが形成されたフォトマスクを介して光照射を行い、前記レジストを感光させる。続いて現像、ポストバークを行い、フォトマスクのパターン状にレジストパターンを形成する。さらにパターン状に形成した前記レジストをマスクとして、前記レジストの下の導電性膜にエッチング処理を施す。最後にマスクとして使用したレジストパターンを剥離すること

で、フォトリソグロフィに形成されたパターン状に、導電性膜をエッチングすることができ、残存する導電性膜を配線として用いる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来技術における真空プロセスにあつては、第5世代以降のメータ角サイズ（1.2m×1m）という大型化に伴い、プロセスチャンバの容積も拡大する。このためプロセスチャンバを真空或いは減圧状態にするには、より大規模な排気系が必要となり、また排気に必要な時間も増加する。さらに排気系の設備コストや維持コスト等、コスト面においても増大する。加えて、チャンバを窒素等のガスで置換する場合にも、チャンバの容積増大からより多くのガス量が必要となり、製造コストに影響を及ぼす。さらに基板の大型化に伴い電源等、莫大なランニングコストが必要とされることから、環境負荷の増大につながる。

【0006】

また従来技術におけるフォトリソグラフィプロセスを用いた工程、例えば配線作製工程では、基板の全面に成膜した被膜（レジストや、金属、半導体等）の大部分をエッチング除去してしまい、配線等が基板に残存する割合は数～数十％程度であつた。レジスト膜はスピン塗布により形成する際、約95％が無駄になつていた。つまり、材料の殆どを捨てることになり、製造コストに影響を及ぼすばかりか、環境負荷の増大を招いていた。このような傾向は、製造ラインに流れる基板サイズが大型化するほど顕在化する。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明では、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する液滴噴射装置を用いて、被処理膜上に導電性粒子を含有する液滴を噴射し、局所的に導電性膜を形成し、配線を形成することを特徴としている。これにより、フォトリソグラフィ工程を用いずに配線を形成でき、工程を簡略化できる。

【0008】

さらに、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する第2の液滴噴射

装置を用いて前記導電性膜の上に局所的にレジストパターンを形成し、前記レジストパターンをマスクとして前記導電性膜をエッチングし、配線を形成することを特徴としている。これにより、スピン法を用いたフォトリソグラフィよりも、レジストの使用量を大きく低減できる。

【0009】

また、前記導電性膜のエッチングは、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力で局所的に行うことを特徴とする。これにより、プロセスチャンバ内の真空或いは減圧状態にするための真空処理を必要とせず、排気系に係る負担を低減できる。

【0010】

ここで、大気圧近傍の圧力とは、600～106000Paの圧力をいう。

【0011】

また、本発明の表示装置の作製方法は、被処理基板上に導電性膜を形成した後、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力で、前記導電膜の不要な部分を局所的にエッチングし、配線を形成することを特徴としている。これにより、フォトリソグラフィ工程を用いずに配線を形成でき、工程を簡略化できる。

【0012】

【発明の実施の形態】

（実施の形態1）

本実施の形態では、複数の液滴噴射孔を線状に配置した液滴噴射ヘッドを有する液滴噴射装置と、大気圧又は大気圧近傍下におけるプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いることで、所望のサイズのガラス基板に、表示装置として不可欠な配線パターンを作製する。特に本発明は大型化する第5世代以降のメータ角基板への適用を意図したものである。以下、本発明の実施の形態1について、図面を参照して説明する。

【0013】

最初にスパッタまたはCVD法（化学気相反応法）等を用いて、ガラス、石英、半導体、プラスチック、プラスチックフィルム、金属、ガラスエポキシ樹脂、セラミックなどの各種素材の被処理基板101上に配線となる導電性膜102を成膜する（図1（B））。被処理基板101の材料としては、本発明の作製工程の処理温度に耐えられる材料であれば、どのようなものでも構わない。次に、後述する複数の液滴噴射孔を線上に配置した液滴噴射ヘッド105を有する液滴噴射装置を用いて（図1（C））、配線パターンの形成部に複数のレジストパターン103を形成する（図1（D））。レジストパターン103の形成後、ベーク処理をする。前記レジストパターン103の各々は、複数の液滴噴射孔から液滴が噴射されることにより形成された複数のパターンが繋がった形状を有する。これは、一方向に液滴噴射ヘッド105を走査する間、ある時間隔ごとに液滴を噴射することにより、レジストパターン103の形状を形成する。なお、複数有る液滴噴射孔のうち、特定の液滴噴射孔のみから連続的に液滴が噴射される用に制御することで、上記のような線状パターンだけでなく、例えばT字形のパターンなど、任意のパターンを形成することが可能である。次に、上記レジストパターン103をマスクとして、後述する大気圧又は大気圧近傍下におけるプラズマ発生手段106を有するプラズマ処理装置を用いて、導電性膜102をエッチングする（図2（A））。前記エッチングは、プラズマ発生手段を一方向に（若しくは、被処理基板を一方向に）走査させることで行う。このときエッチングガスとして、導電性膜と反応するガスを使用する。上記のエッチング処理を行うことによって、前記レジストパターン103のが被覆しておらず、露出した導電性膜102のみがエッチングされる（図2（B））。前記エッチング処理後、不要になったレジストパターン103を同様の前記プラズマ処理装置を用いてアッシングを行い、除去する（図2（C））。前記アッシング時のプラズマ発生手段の走査は、前記エッチング時と同様に行う。その結果レジストパターン形成箇所の導電性膜のみが残り、配線パターン104が形成される（図2（D））。なお、アッシング時のガスとしてはレジストに反応性の高い酸素ガスを用いる。

【0014】

以下、本発明で用いる点状の液滴噴射孔を線状に配置した液滴噴射ヘッドを有

する点状液滴噴射装置を、添付図面を参照して説明する。

【0015】

図3は本発明における線状液滴噴射装置の一構成例について示したものであり、また図4、図5はこの線状液滴噴射装置に用いる、ノズルを配置したヘッド部について示したものである。

【0016】

図3(A)に示す線状液滴噴射装置は、装置内にヘッド306を有し、これにより液滴を噴射することで、基板302に所望の液滴パターンを得るものである。本線状液滴噴射装置においては、基板302として、所望のサイズのガラス基板の他、プラスチック基板に代表される樹脂基板、或いはシリコンに代表される半導体ウエハ等の被処理物に適用することができる。

【0017】

図3(A)において、基板302は搬入口304から筐体301内部へ搬入し、液滴噴射処理を終えた基板を搬出口305から搬出する。筐体301内部において、基板302は搬送台303に搭載され、搬送台303は搬入口と搬出口とを結ぶレール310a、310b上を移動する。

【0018】

ヘッド支持部307は、液滴を噴射するヘッド306を支持し、搬送台303と平行に移動する。基板302が筐体301内部へ搬入されると、これと同時にヘッド支持部307が所定の位置に合うように移動する。ヘッド306の初期位置への移動は、基板搬入時、或いは基板搬出時に行うことで、効率良く噴射処理を行うことができる。

【0019】

液滴噴射処理は、搬送台303の移動により基板302が、ヘッド306の待つ所定の位置に到達すると開始する。液滴噴射処理は、ヘッド支持部307及び基板302の相対的な移動と、ヘッド支持部に支持されるヘッド306からの液滴噴射の組み合わせによって達成される。基板やヘッド支持部の移動速度と、ヘッド306からの液滴を噴射する周期を調節することで、基板302上に所望の液滴パターンを描画することができる。特に、液滴噴射処理は高度な精度が要求

されるため、液滴噴射時は搬送台の移動を停止させ、制御性の高いヘッド支持部 307のみを順次走査させることが望ましい。また、ヘッド306のは一方向に前後するようにも走査可能である。

【0020】

原料液は、筐体301外部に設置した液滴供給部309から筐体内部へ供給され、さらにヘッド支持部307を介してヘッド306内部の液室に供給される。この原料液供給は筐体301外部に設置した制御手段308によって制御されるが、筐体内部におけるヘッド支持部307に内蔵する制御手段によって制御しても良い。

【0021】

また搬送台及びヘッド支持部の移動は、同様に筐体301外部に設置した制御手段308により制御する。

【0022】

図3 (A) には記載していないが、さらに基板や基板上のパターンへの位置合わせのためのセンサや、筐体へのガス導入手段、筐体内部の排気手段、基板を加熱処理する手段、基板へ光照射する手段、加えて温度、圧力等、種々の物性値を測定する手段等を、必要に応じて設置しても良い。またこれら手段も、筐体301外部に設置した制御手段308によって一括制御することが可能である。さらに制御手段308をLANケーブル、無線LAN、光ファイバ等で生産管理システム等に接続すれば、工程を外部から一律管理することが可能となり、生産性を向上させることに繋がる。

【0023】

次にヘッド306内部の構造を説明する。図4は図3 (A) のヘッド306の断面を長手方向に見たものであり、図4の右側がヘッド支持部に連絡する。

【0024】

外部からヘッド401の内部に供給される液滴は、共通液室流路402を通過した後、液滴を噴射するための各ノズル409へと分配される。各ノズル部は適度の液滴がノズル内へ装填されるために設けられた流体抵抗部403と、液滴を加圧しノズル外部へ噴射するための加圧室4

04、及び液滴噴射孔406によって構成されている。

【0025】

加圧室404の側壁には、電圧印加により変形するチタン酸・ジルコニウム酸・鉛 ($\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$) 等の piezo 圧電効果を有する圧電素子405を配置している。このため、目的のノズルに配置された圧電素子405に電圧を印加することで、加圧室404内の液滴を押しだし、外部に液滴407を噴射することができる。また各圧電素子はこれに接する絶縁物408により絶縁されているため、それぞれが電氣的に接触することがなく、個々のノズルの噴射を制御することができる。

【0026】

本発明では液滴噴射は圧電素子を用いたいわゆる piezo 方式で行うが、液滴の材料によっては、発熱体を発熱させ気泡を生じさせ液滴を押し出す、いわゆるサーマルインクジェット方式を用いても良い。この場合、圧電素子405を発熱体に置き換える構造となる。

【0027】

また液滴噴射のためのノズル部409においては、液滴と、共通液室流路402、流体抵抗部403、加圧室404さらに液滴噴射孔407との濡れ性が重要となる。そのため材質との濡れ性を調整するための炭素膜、樹脂膜等をそれぞれの流路に形成しても良い。

【0028】

上記の手段によって、液滴を連続して噴射させ、各々の液滴から形成されるパターンが繋がった所望の形状のパターンを形成することができる。

【0029】

図5の(A)～(C)は図4におけるヘッドの底部を模式的に表したものである。図5(A)は、ヘッド501底面に液滴噴射孔502を線状に配置したものである。これに対し図5(B)では、ヘッド底部503の液滴噴射孔504を2列にし、それぞれの列を半ピッチずらして配置する。また図5(C)では、ピッチをずらすことなく列を2列に増やした配置とした。図5(C)の配置では、一段目の液滴噴射孔506からの液滴噴射後、時間差をつけて液滴噴射孔507か

ら同様の液滴を同様の箇所に噴射することにより、既に噴射された基板上の液滴が乾燥や固化する前に、さらに同一の液滴を厚く積もらせることができる。また、一段目のノズル部が液滴等により目詰まりが生じた場合、予備として二段目の液滴噴射孔を機能させることもできる。

【0030】

さらに図3 (A) で示す線状液滴噴射装置に改良を加えた、図3 (B) で示す線状液滴噴射装置について説明する。本装置ではヘッド支持部307に回転手段を設け、任意の角度 θ に回転することで、基板302に対しヘッド306が角度を持たせるように設計したものである。角度 θ は任意の角度が許されるが、装置全体のサイズを考慮すると基板302が移動する方向に対し、 0° から 45° 以内であることが望ましい。このヘッド支持部307に回転手段を持たせることにより、ヘッドに設けられた液滴噴射孔のピッチよりも狭いピッチで、液滴パターンを描画することができる。

【0031】

また図3 (C) は、図3 (A) で示す線状液滴噴射装置のヘッド306を二つ配置した、ツインヘッド構造の線状液滴噴射装置である。本装置においては、図5 (C) で示したヘッド内部に二列の液滴噴射孔を配置するのと異なり、材質の異なる液滴を同一の走査で一括して行うことができる。つまり、ヘッド306aで原料液Aの噴射によるパターン形成を行いながら、僅かな時間差を置いてヘッド306bによる原料液Bの噴射によるパターン形成を行うという連続パターン形成を可能とした。309aと309bは原料液供給部であり、それぞれのヘッドで用いる原料液A及び原料液Bを備蓄し、供給する。このツインヘッド構造を用いることで、工程が簡略化することができ、著しく効率を上げることが可能となる。

【0032】

次に、実施の形態1で用いる大気圧又は大気圧近傍下におけるプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を、添付図面を参照して説明する。図6は、本発明において用いられる前記プラズマ処理装置の一例斜視図である。前記プラズマ処理装置では、表示装置を構成する、所望のサイズのガラス基板、プラスチック基板に代表される樹脂基板等の被処理物602を取り扱う。被処理物602の搬送方

式としては、水平搬送が挙げられるが、第5世代以降のメータ角の基板を用いる場合には、搬送機の占有面積の低減を目的として、基板を縦置きにした縦形搬送を行ってもよい。

【0033】

図6（A）は、本発明において用いられるプラズマ処理装置の一例の上面図であり、図6（B）は断面図である。同図において、カセット室606には、所望のサイズのガラス基板、プラスチック基板に代表される樹脂基板等の被処理物603がセットされる。被処理物603の搬送方式としては、水平搬送が挙げられるが、第5世代以降のメータ角の基板を用いる場合には、搬送機の占有面積の低減を目的として、基板を縦置きにした縦形搬送を行ってもよい。

【0034】

搬送室607では、カセット室606に配置された被処理物603を、搬送手段（ロボットアーム）609によりプラズマ処理室608に搬送する。搬送室607に隣接するプラズマ処理室608には、気流制御手段601、円筒状の電極を有するプラズマ発生手段602、プラズマ発生手段602を移動させるレール604a、604b、被処理物603の移動を行う移動手段605等が設けられる。また、必要に応じて、ランプなどの公知の加熱手段（図示せず）が設けられる。

【0035】

気流制御手段601は、防塵を目的としたものであり、吹き出し口610から噴射される不活性ガスを用いて、外気から遮断されるように気流の制御を行う。プラズマ発生手段602は、被処理物603の搬送方向に配置されたレール604a、また該搬送方向に垂直な方向に配置されたレール604bにより、所定の位置に移動する。また被処理物603は、移動手段605により搬送方向に移動する。実際にプラズマ処理を行う際には、プラズマ発生手段602及び被処理物603のどちらを移動させてもよい。プラズマ発生手段602と被処理物603との距離は3mm以下、好ましくは1mm以下、より好ましくは0.5mm以下が良い。特に距離を測定するためのセンサを取り付け、前記被処理物603表面とのプロセスガスの噴射口となる細口との距離を制御しても良い。

【0036】

次いで、プラズマ発生手段602の詳細について図7を用いて説明する。図7(A)～(B)は、円筒状の電極を有するプラズマ発生手段602の斜視図を示し、図7(C)～(E)には該円筒状の電極の断面図を示す。

【0037】

図7(A)は後述する一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段602aを模式的に示した図である。プラズマ発生手段602aは局所的にプラズマ処理する事が可能である。またこれに対し図7(B)は、後述する円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段602bを模式的に示した図である。プラズマ発生手段602bはこのような配列を有することにより同時に同列全域をプラズマ処理することが可能である。このため被処理物603の移動方向に対して直交する方向に、前記直線状に配列した電極を有するプラズマ発生手段602bを走査することで、短時間で大面積のプラズマ処理を行うことが可能となる。また前記電極を選択することにより、同列における任意の場所で局所的なプラズマ処理をすることが可能である。なお、プラズマ処理とは、成膜、エッチング、アッシングなどのプラズマ反応を利用する処理をいう。

【0038】

次に図7(C)において、上述した一組の円筒状の電極について説明する。点線はガスの経路を示し、701、702はアルミニウム、銅などの導電性を有する金属からなる電極であり、第1の電極701は電源(高周波電源)705に接続されている。なお第1の電極701には、冷却水を循環させるための冷却系(図示せず)が接続されていてもよい。冷却系を設けると、冷却水の循環により連続的に表面処理を行う場合の加熱を防止して、連続処理による効率の向上が可能となる。第2の電極702は、第1の電極701の周囲を取り囲む形状を有し、電氣的に接地されている。そして、第1の電極701と第2の電極702は、その先端にノズル状のガスの細口を有する円筒状を有する。この第1の電極701と第2の電極702の両電極間の空間には、バルブ703を介してガス供給手段(ガスボンベ)704よりプロセス用ガスが供給される。そうすると、この空間の雰囲気は置換され、この状態で高周波電源705により第1の電極701に高

周波電圧（10～500MHz）が印加されると、前記空間内にプラズマが発生する。そして、このプラズマにより生成されるイオン、ラジカルなどの化学的に活性な励起種を含む反応性ガス流を被処理物603の表面に向けて照射すると、該被処理物603の表面において所定の表面処理を行うことができる。

【0039】

なおガス供給手段（ガスボンベ）704に充填されるプロセス用ガスは、処理室内で行う表面処理の種類に合わせて適宜設定する。また、排気ガス706は、ガス中に混入したゴミを除去するフィルタ707とバルブ708を介して排気系709に導入される。なお排気系709に導入されたガスはフィルタを通過させることで、混入したゴミを除去して精製し、再利用を図ってもよい。このように再利用を行うことにより、ガスの利用効率を向上させることができる。

【0040】

また、図7（C）とは断面が異なる円筒状の電極602を図7（D）（E）に示す。図7（D）は、第1の電極701の方が第2の電極702よりも長く、且つ第1の電極701が鋭角形状を有しており、また、図7（E）に示すプラズマ発生手段602は、第1の電極701及び第2の電極702の間で発生したイオン化したガス流を外部に噴射する形状を有する。

【0041】

大気圧又は大気圧近傍下で動作するプラズマ処理装置を用いる本発明は、減圧装置に必要である真空引きや大気開放の時間が必要なく、複雑な真空系を配置する必要がない。特に大型基板を用いる場合には、必然的にチャンバも大型化し、チャンバ内を減圧状態にすると処理時間もかかってしまうため、大気圧又は大気圧近傍下で動作させる本装置は有効であり、製造コストの低減が可能となる。

【0042】

（実施の形態2）

本実施の形態では、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する線状液滴噴射装置のみを使用することで配線を形成することを特徴とする。

【0043】

線状液滴噴射装置からガラス基板801に向かって、導電性超微粒子を含む材

料を噴射する。このとき、液滴を噴射するヘッド 802 またはガラス基板 801 を走査することによって、配線パターンを形成する。(図 8 (B))。配線パターンの形成されたガラス基板 801 を加熱処理することにより配線 804 を形成する(図 8 (C))。

【0044】

図 8 に示すように噴射する液滴をレジストから、導電性超微粒子を含む材料に換えることで、直接パターンニングされた配線が作成できる。これにより、レジストマスクが必要で無くなり、さらなる高効率化、低コスト化が可能である。導電性微粒子のサイズが小さく、また細密な形状に加工する必要のない場合には、以上のような方法を用いることが有効である。

【0045】

配線を形成するときの材料としては、ペースト状の金属材料または前記ペースト状の金属を含んだ有機系溶媒、超微粒子状の金属材料或いは前記金属材料を含んだ有機系溶媒等を用いることが可能である。

【0046】

(実施の形態 3)

本実施の形態では、前記プラズマ処理装置のみを使用し、配線を形成することを特徴とする。以下、本実施の形態について説明する。

【0047】

最初にスパッタ処理方法を用いて、被処理基板 901 に配線となる導電性膜 902 を成膜する(図 9 (A)、(B))。次に、実施の形態 1 でも用いた、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力下で導電性膜 902 を選択的にエッチングする(図 9 (C))。前記エッチングは、被処理基板 901 を一方向に(若しくはプラズマ発生手段 903 を一方向に)走査し、導電性膜 902 のうち、除去する必要の有る部分のみを選択的にエッチング処理するようにして行う。

【0048】

以上のように、被処理物上を選択的にエッチングし、分離することで配線 90

4 を形成することが出来る（図 9（D））。

【0049】

以上のような方法により、レジストパターンの形成工程が省略され、工程を簡略化することができる。

【0050】

【実施例】

（実施例 1）

本実施例では、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する液滴噴射装置および一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を用いて、局所的なプラズマ表面処理を行うプラズマ処理装置を用いて、本発明を適用した表示装置の作製方法について説明する。

【0051】

ガラス、石英、半導体、プラスチック、プラスチックフィルム、金属、ガラスエポキシ樹脂、セラミックなどの各種材料とする被処理基板 1001 上に、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する液滴噴射装置により、導電性を有する組成物を必要な箇所に噴射することで、ゲート電極及び配線 1002、容量電極及び配線 1003 を形成する（図 10（A））。ここでは、ゲート電極および配線 1002 は一体化した構造となっている。また容量電極および容量電極に接続する配線も一体化して形成されている。

【0052】

次に、ゲート電極及び配線 1002、容量電極及び配線 1003 が形成された基板に加熱処理等を施すことで、液滴中に含有されているの溶媒を揮発させる。なお前記加熱処理は、線状の液滴噴射装置による液滴噴射時、任意の領域での液滴噴射後、或いは全工程終了後のいずれに行っても良い。

【0053】

続いて、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する線状液滴噴射装置を用いて、前記工程で噴射したゲート電極及び配線 1002、容量電極及び配線 1003 を覆うレジスト 1004、1005 を形成する（図 10（B））。な

お、ゲート電極及び配線 1002、容量電極及び配線 1003 を形成するために用いる線状液滴噴射装置と、レジストを形成する線状液滴噴射装置とはそれぞれ別の装置であってもよいし、或いは材料の異なる液滴をそれぞれ噴射することが可能な 2 つのヘッドを有する一つ装置であってもよい。

【0054】

次に、露光および現像をして前記レジストを所望の形状に加工しレジストパターンを形成する。(図 10 (C))。なお、線状液滴噴射装置を用い形成されたレジストの形状をそのままマスクとして用いることができる場合は、特に露光および現像によるレジストの加工は必要ない。

【0055】

次に一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力下でプラズマを形成し、レジスト 1004、1005 をマスクとして、ゲート電極及び配線 1002、容量電極及び配線 1003 の任意の場所を局所的にエッチングした後、前記プラズマ処理装置を用いてアッシングによりレジストを除去する(図 11 (A)、(B))。なお、本実施例では、上記のような局所的なエッチングをしているが、公知のエッチング装置を用いても構わない。

【0056】

以上の工程によりゲート電極及び配線 2002、容量電極及び配線 2003 を形成する。なおゲート電極及び配線 2002、容量電極及び配線 2003 を形成する材料としてはモリブデン (Mo)、チタン (Ti)、タンタル (Ta)、タングステン (W)、クロム (Cr)、アルミニウム (Al)、銅 (Cu)、ネオジム (Nd) を含むアルミニウム (Al) 等や、これらの積層または合金のような導電性材料を用いることが可能である。

【0057】

その後、CVD法(化学気相反応法)等の公知の方法により、ゲート絶縁膜 1006 を形成する(図 11 (C))。本実施例においてはゲート絶縁膜 1006 として、CVD法により窒化珪素膜を形成するが、酸化珪素膜又はそれらの積層構造

を形成しても良い。

【0058】

さらにスパッタリング法、LP（減圧）CVD法、プラズマCVD法等により25～80nm（好ましくは30～60nm）の厚さで活性半導体層1007を成膜する。該活性半導体層1007は非晶質珪素膜に代表される非晶質半導体膜であり、被処理基板1001上の全面に形成する（図12（A））。

【0059】

次に被処理基板上の全面に窒化珪素膜等を成膜後、レジストマスクを用いてチャネル保護膜（エッチング停止膜）1008を形成する（図12（B））。該チャネル保護膜1008の形成には、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する線状液滴噴射装置を用いてもよいし、或いはスピコート法によるレジスト成膜工程を有するフォトリソグラフィプロセスを用いても良い。

【0060】

続いてN型の電導型を付与する不純物元素が添加された非晶質半導体膜1009を、被処理基板上の全面に形成する（図12（C））。

【0061】

その後、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する線状液滴噴射装置を用いてソース・ドレイン電極及び配線1010、1011を形成する（図13（A））。なおソース・ドレイン電極及び配線1010、1011は、図10（A）乃至図11（B）に示したゲート電極及び配線1002、容量電極及び配線1003と同様にパターニングを行えば良い。ソース・ドレイン電極及び配線1010、1011を形成する材料としては、ゲート電極、配線と同様にモリブデン（Mo）、チタン（Ti）、タンタル（Ta）、タングステン（W）、クロム（Cr）、アルミニウム（Al）、銅（Cu）、ネオジウム（Nd）を含むアルミニウム（Al）等や、これらの積層または合金のような導電性材料を用いることが可能である。

【0062】

その後、ソース・ドレイン電極及び配線1010、1011をマスクとして、N型の導電型を付与する不純物元素が添加された非晶質半導体膜1009を、一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直

線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて大気圧若しくは大気圧近傍の圧力下でプラズマを形成し、これを走査することで任意の場所をエッチングする（図 13 (B)）。

【0063】

さらにCVD法などにより、保護膜 1012 を形成する（図 13 (C)）。本実施例では、保護膜 1012 としてCVD法により窒化珪素膜を形成するが、酸化珪素膜、又はそれらの積層構造を形成しても良い。またアクリル膜等、有機系樹脂膜を使用することもできる。

【0064】

その後、線状液滴噴射装置によりレジストを噴射した後、公知のフォトリソグラフィプロセスによりレジストをパターンニングする（図示せず）。さらに一組の円筒状の電極を有するプラズマ発生手段、若しくは円筒状の電極を複数組直線状に配列させたプラズマ発生手段を有するプラズマ処理装置を用いて、大気圧若しくは大気圧近傍の圧力下でプラズマを形成し、保護膜 1012 のエッチングを行い、コンタクトホール 1013 を形成する（図 14 (A)）。

【0065】

その後、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する線状液滴噴射装置により、画素電極 1014 を形成する（図 14 (B)）。該画素電極 1014 は、線状液滴噴射装置により直接描画しても良いし、図 10 (A) 乃至図 11 (B) に示したゲート電極及び配線 1002、容量電極及び配線 2003 と同様にパターンニングを行うことで形成しても良い。該画素電極 1014 の材料としてITO（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（ In_2O_3 ）- ZnO ）、酸化亜鉛（ ZnO ）等の透明導電膜、またはモリブデン（Mo）、チタン（Ti）、タンタル（Ta）、タングステン（W）、クロム（Cr）、アルミニウム（Al）、銅（Cu）、ネオジム（Nd）を含むアルミニウム（Al）等や、これらの積層または合金のような導電性材料を用いることが可能である。

【0066】

以上のようにして、被処理基板上に TFT を作製した後、これをセル組みして表示装置を作製する。なお、セル組みは公知の方法を用いて行えばよい。

【0067】**(実施例2)**

本発明を用いて様々な電気器具を完成させることができる。その具体例について図15を用いて説明する。

【0068】

図15(A)は例えば20～80インチの大型の表示部を有する表示装置であり、筐体2001、支持台2002、表示部2003、スピーカー部2004、ビデオ入力端子2005等を含む。本発明は、表示部2003の作製に適用される。このような大型の表示装置は、生産性やコストの面から、所謂第五世代(1000×1200ミリ)、第六世代(1400×1600ミリ)、第七世代(1500×1800ミリ)のようなメータ角の大型基板を用いて作製することが好適である。

【0069】

図15(B)は、ノート型パーソナルコンピュータであり、本体2101、筐体2102、表示部2103、キーボード2104、外部接続ポート2105、ポインティングマウス2106等を含む。本発明は、表示部2103の作製に適用される。

【0070】

図15(C)は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2201、筐体2202、表示部A2203、表示部B2204、記録媒体(DVD等)読み込み部2205、操作キー2206、スピーカー部2207等を含む。表示部A2203は主として画像情報を表示し、表示部B2204は主として文字情報を表示するが、本発明は、これら表示部A、B2203、2204の作製に適用される。

【0071】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、本発明をあらゆる分野の電気器具の作製に適用することが可能である。また、上記の実施の形態、実施例と自由に組み合わせることができる。

【0072】

【発明の効果】

本発明の表示装置の作製方法を用いて表示装置を作製することで、表示装置の作製に用いられる材料の無駄を低減することが可能となる。従って、作製コストを低減することが可能になる。また本発明の表示装置の作製方法を用いて表示装置を作製することで、工程の簡便化、装置ひいては製造ラインの小規模化、また工程の短時間化を図ることが可能となる。また従来必要とされた排気系統の設備を簡略化できる等、エネルギーを低減できることから環境負荷を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 (A) ～ (D) は、本発明の実施の形態 1 に係る処理工程の模式的斜視図である。

【図 2】 (A) ～ (D) は、本発明の実施の形態 1 に係る処理工程の模式的斜視図である。

【図 3】 (A) ～ (C) は、本発明の点状液滴噴射装置の構成を示す斜視図である。(A) ～ (B) は、

【図 4】 本発明の点状液滴噴射装置の液滴噴射部の構成を示す図である。

【図 5】 (A) ～ (C) は、本発明の点状液滴噴射装置の液滴噴射部の底面を示す図である。

【図 6】 本発明の大気圧又は大気圧近傍下におけるプラズマ処理装置の構成を示す斜視図である。

【図 7】 (A) ～ (D) は、本発明の大気圧プラズマ処理装置のプラズマ発生手段の構成を示す図である。

【図 8】 (A) ～ (C) は、本発明の実施の形態 2 に係る処理工程の模式的斜視図である。

【図 9】 (A) ～ (D) は、本発明の実施の形態 3 に係る処理工程の模式的斜視図である。

【図 1 0】 (A) ～ (C) は、本発明の実施例 1 に係る製造工程の模式図であり、それぞれ左図が上面図であり、右図が左図の a-a' の断面図である。

【図 1 1】 (A) ～ (C) は、本発明の実施例 1 に係る製造工程の模式図であり、

それぞれ左図が上面図であり、右図が左図のa-a'の断面図である。

【図 1 2】 (A) ~ (C) は、本発明の実施例 1 に係る製造工程の模式図であり、それぞれ左図が上面図であり、右図が左図のa-a'の断面図である。

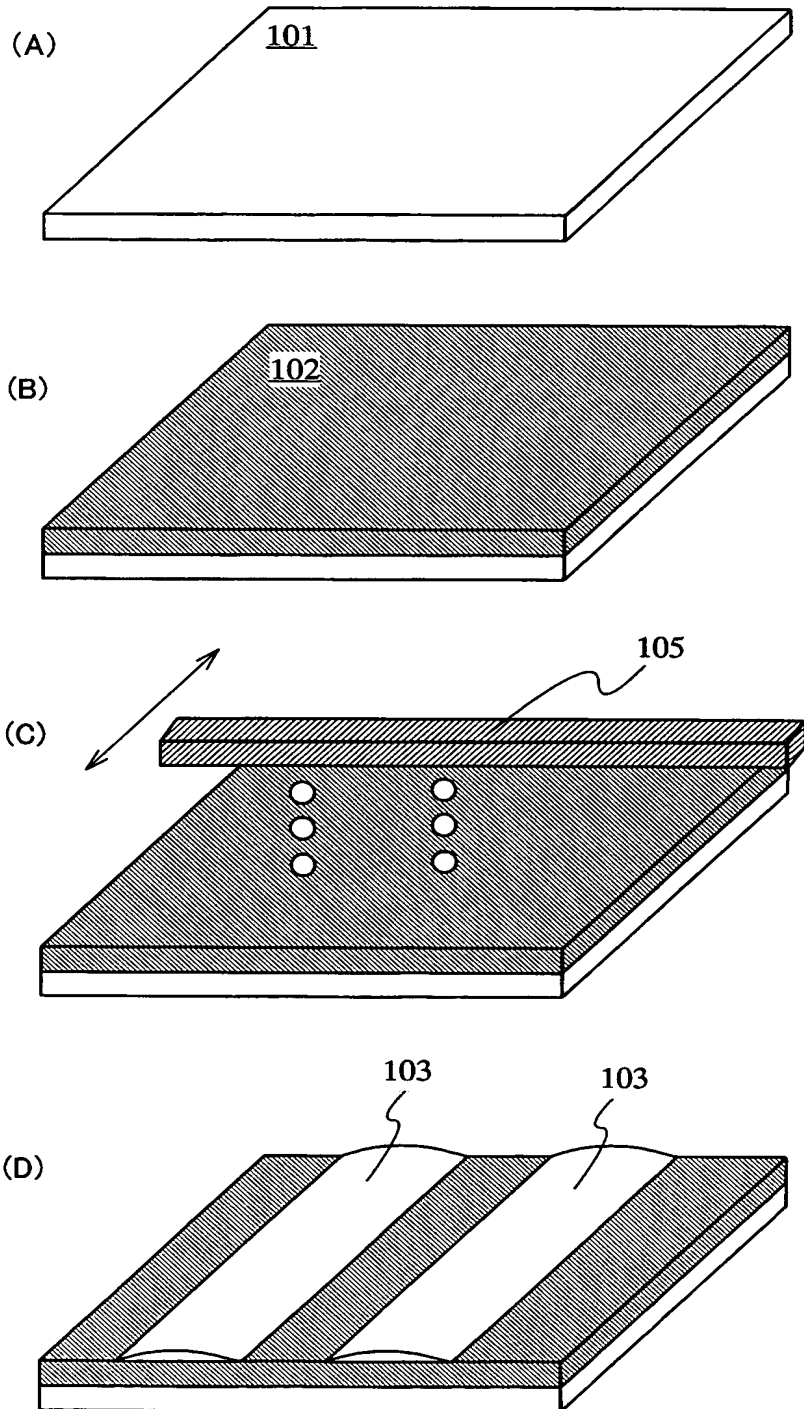
【図 1 3】 (A) ~ (C) は、本発明の実施例 1 に係る製造工程の模式図であり、それぞれ左図が上面図であり、右図が左図のa-a'の断面図である。

【図 1 4】 (A) ~ (B) は、本発明の実施例 1 に係る製造工程の模式図であり、それぞれ左図が上面図であり、右図が左図のa-a'の断面図である。

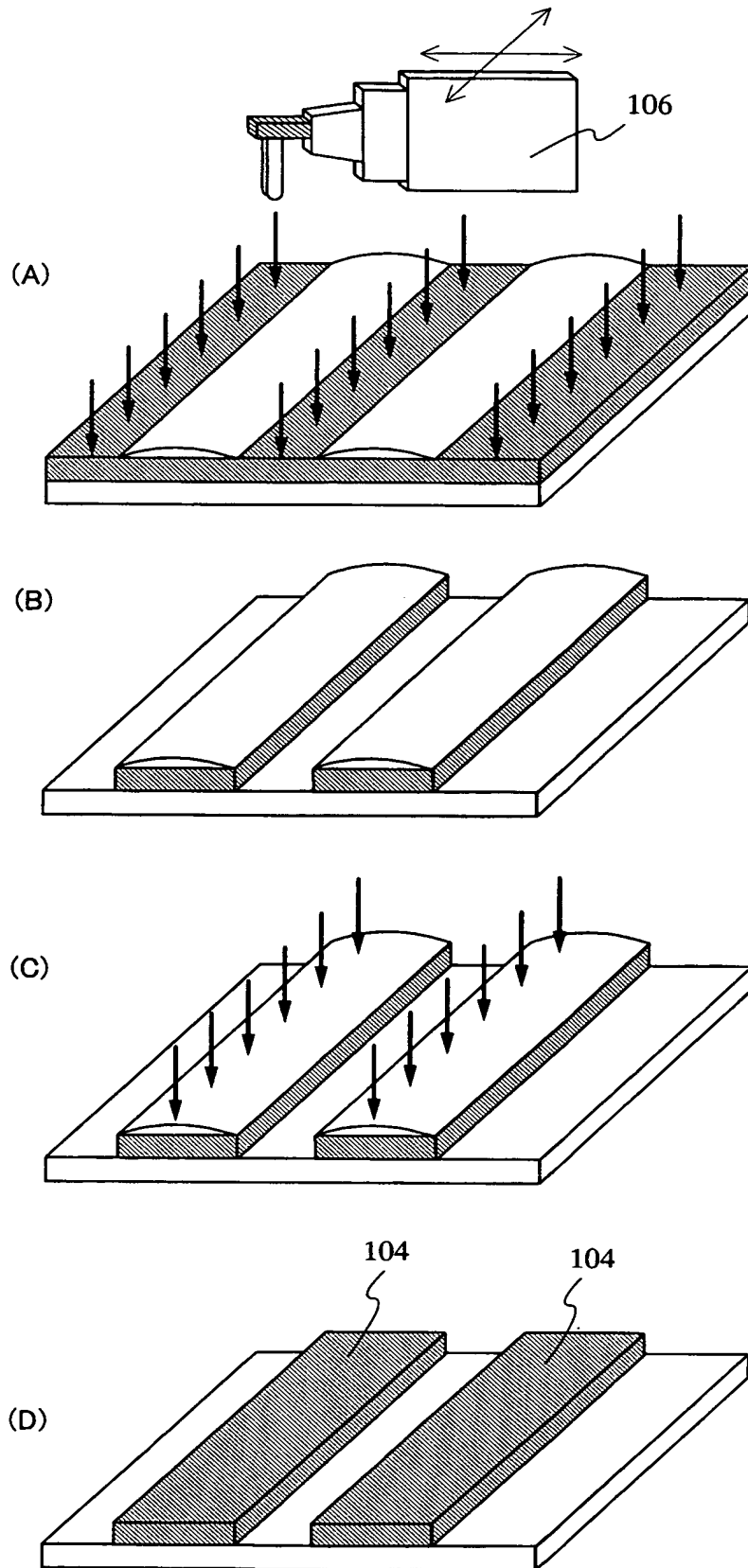
【図 1 5】 (A) ~ (C) は、本発明の実施例 2 に係る電子機器を示す図である。

【書類名】 図面

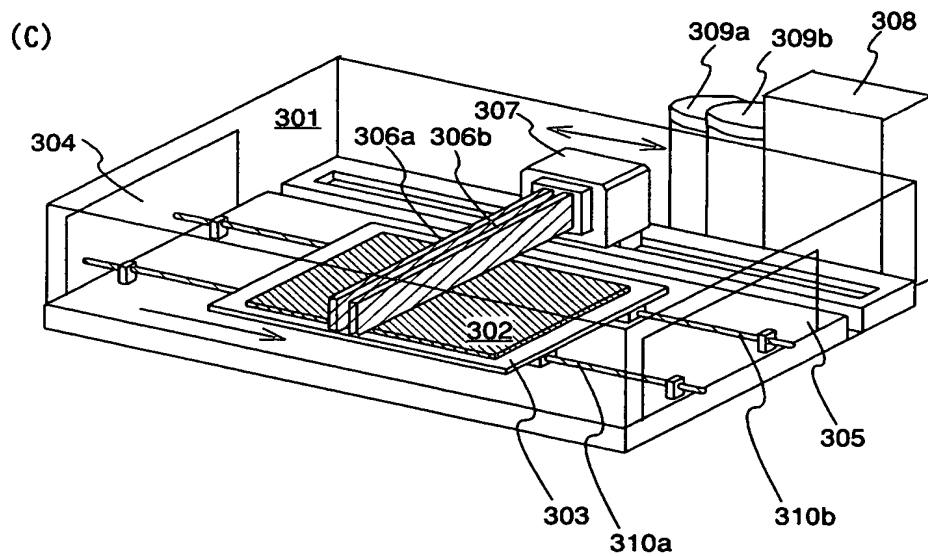
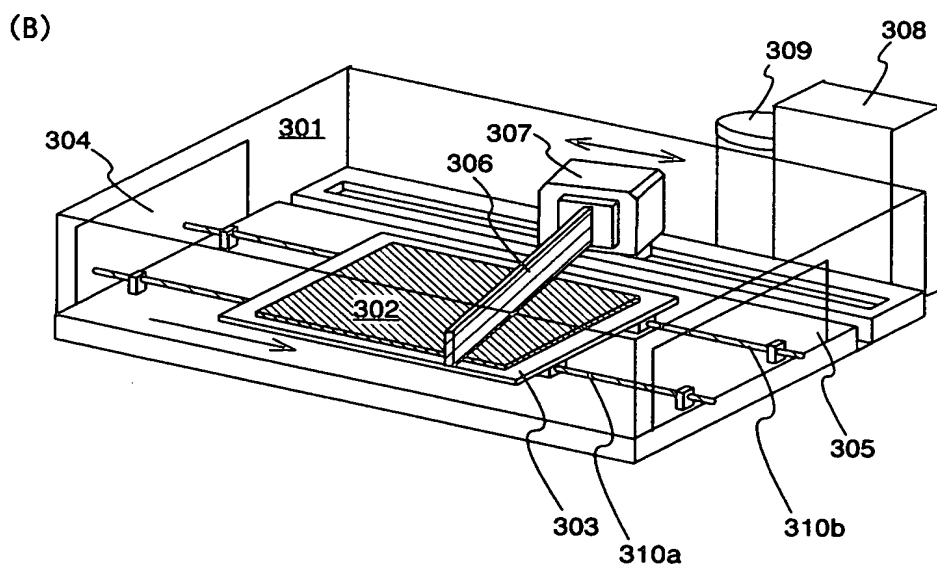
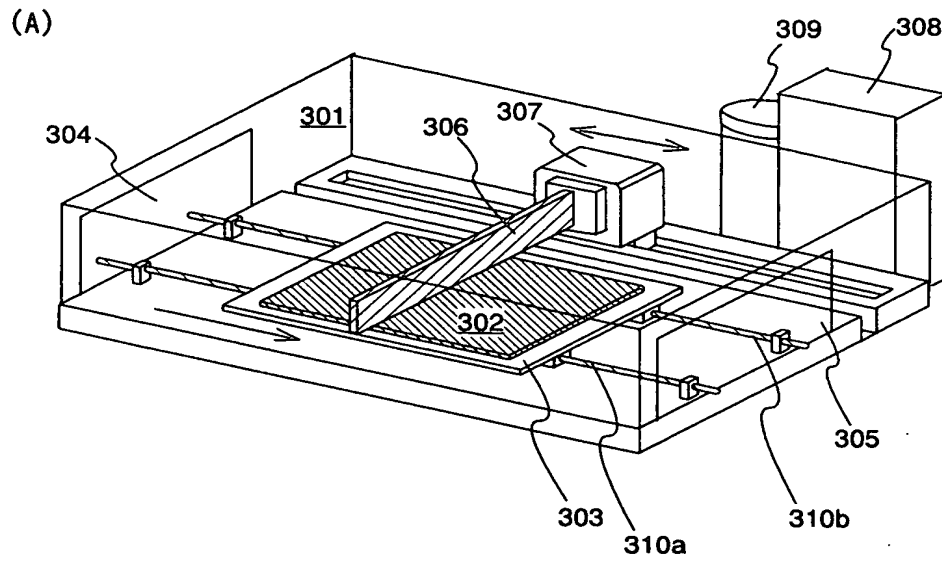
【図 1】



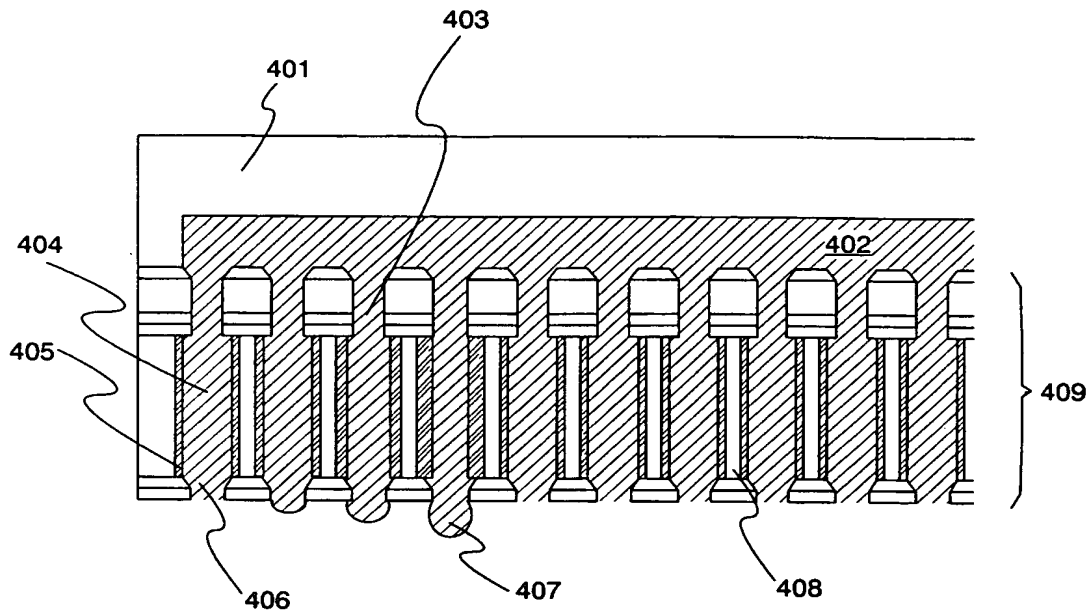
【図 2】



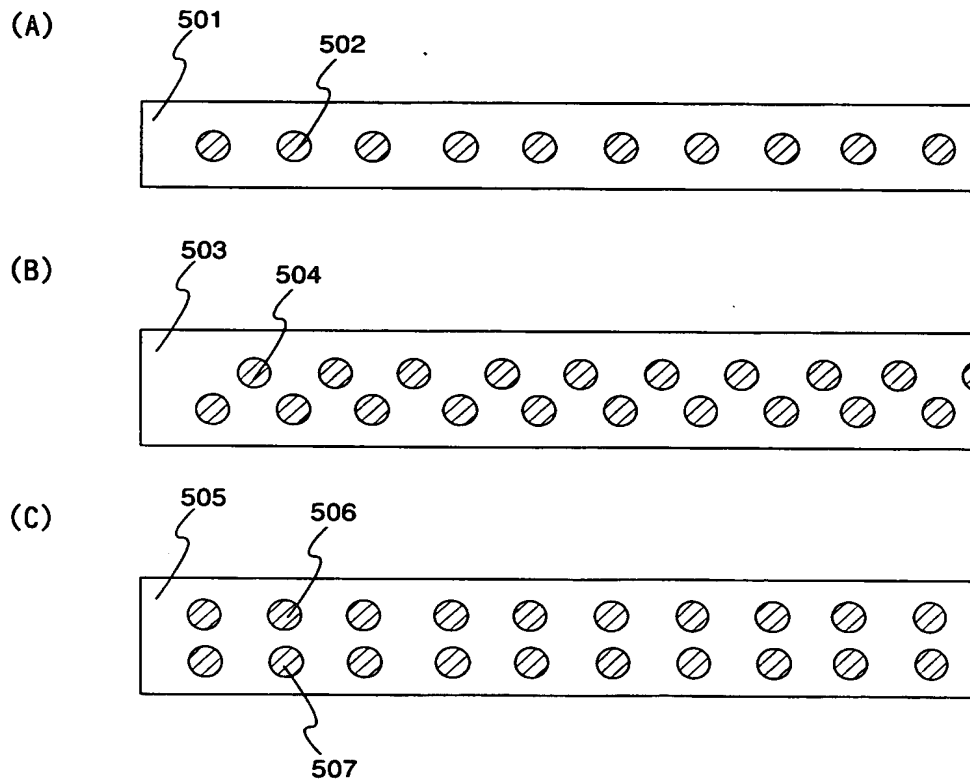
【図 3】



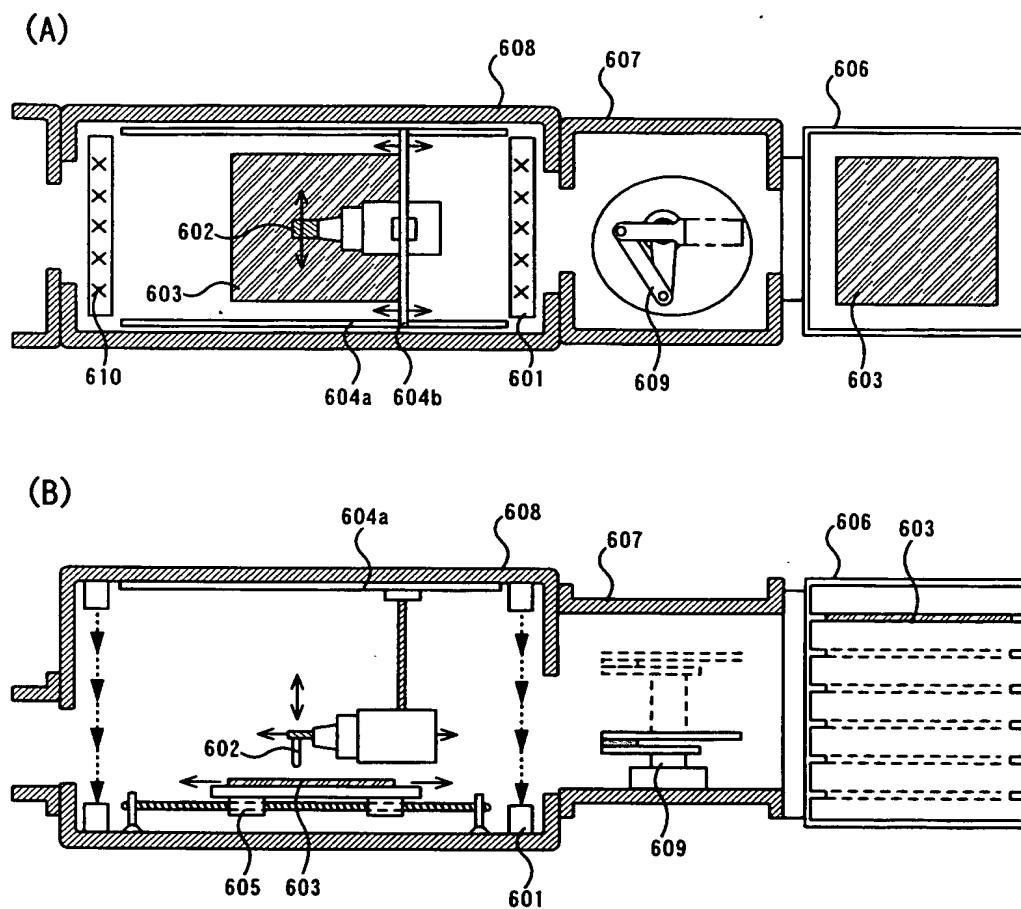
【図 4】



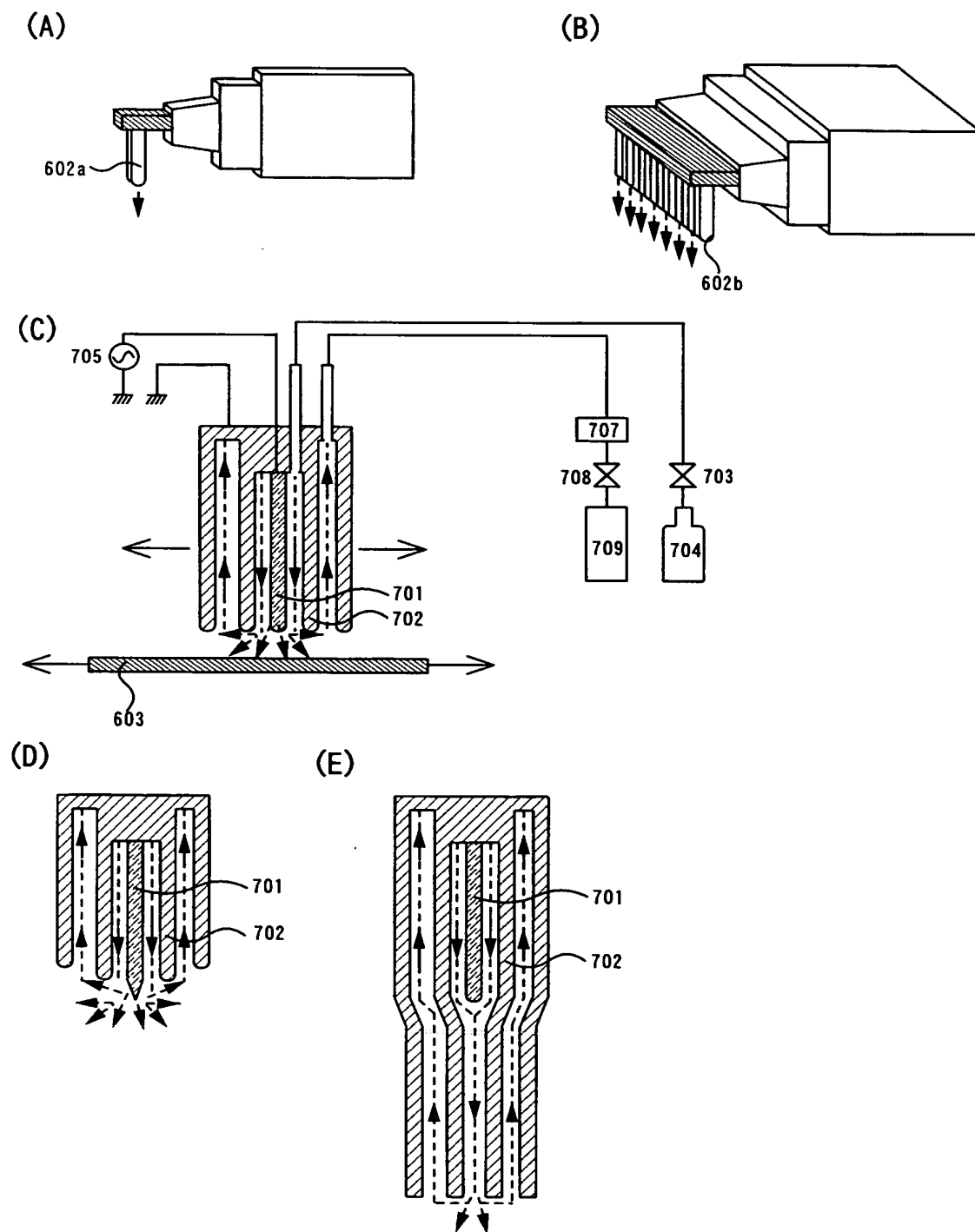
【図 5】



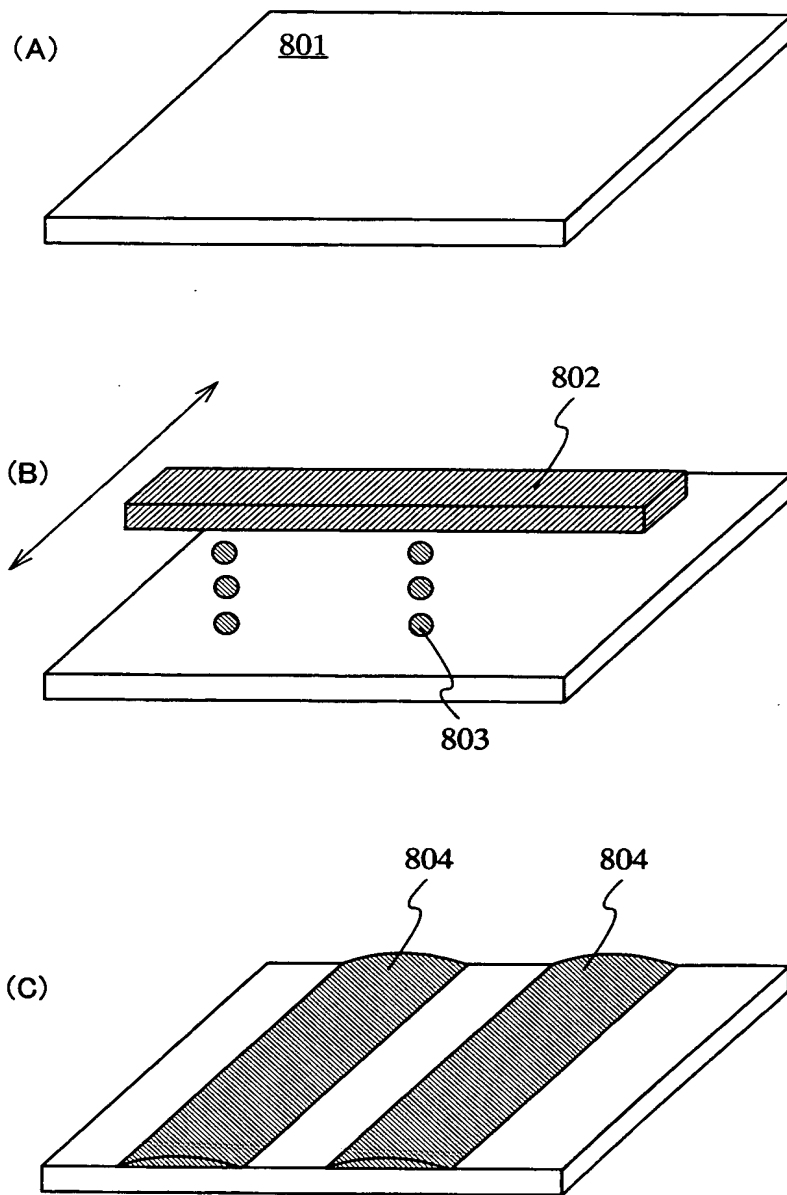
【図 6】



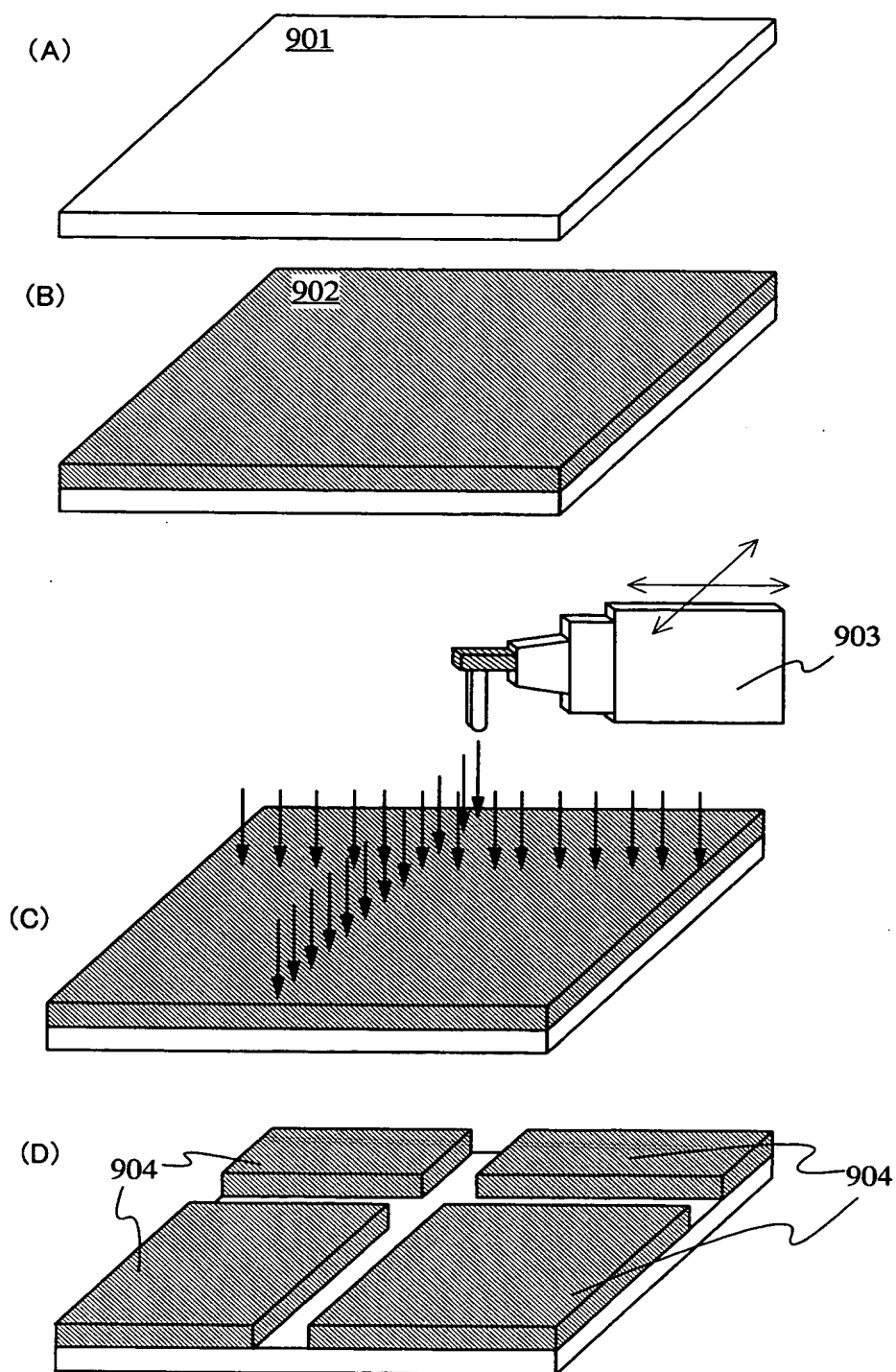
【図 7】



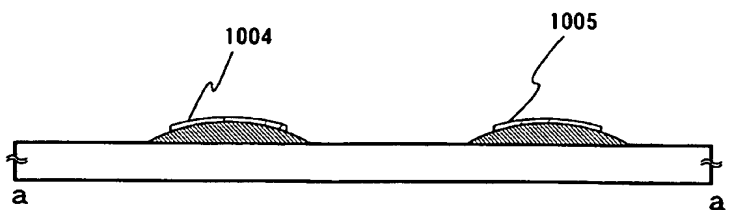
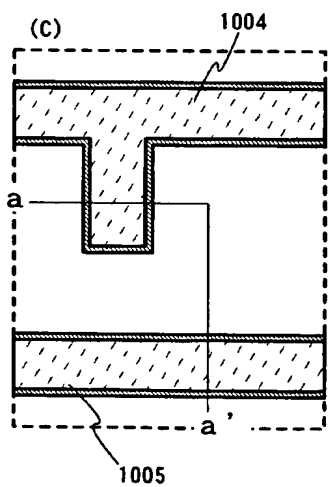
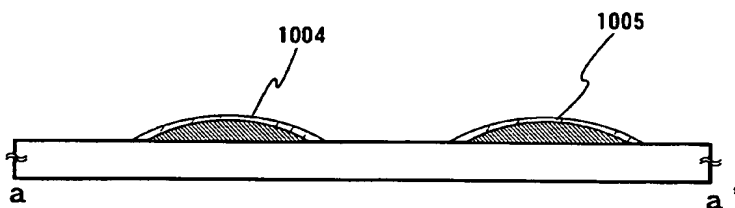
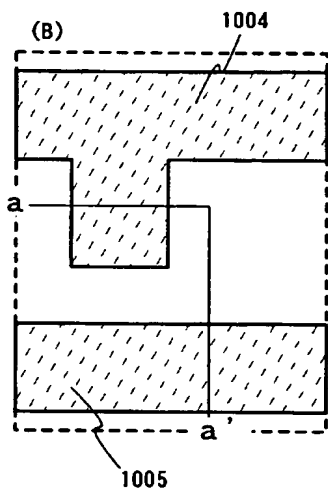
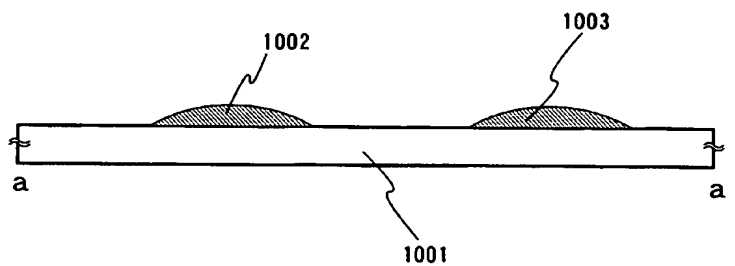
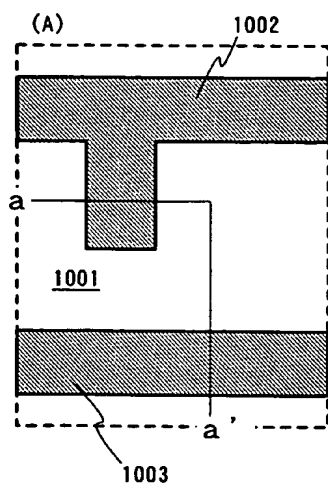
【図 8】



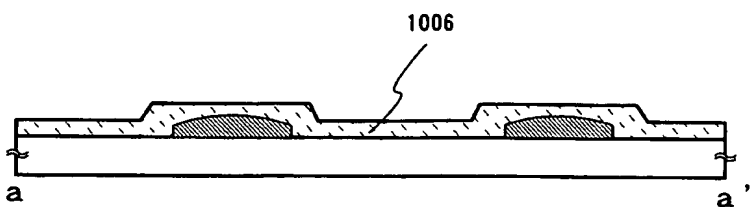
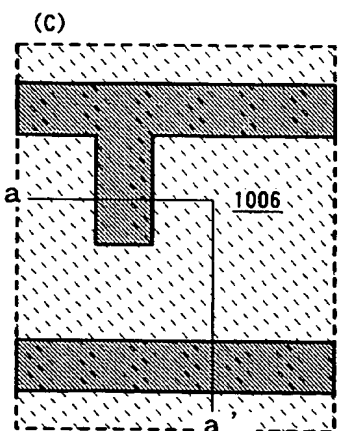
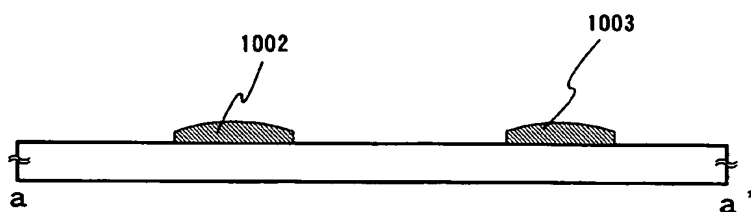
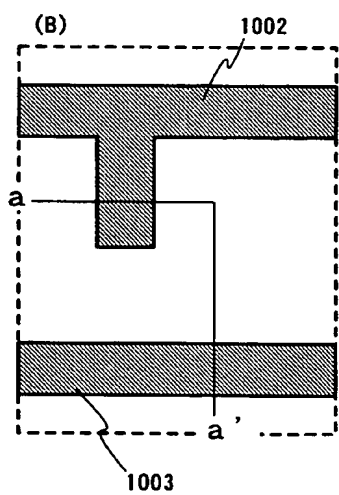
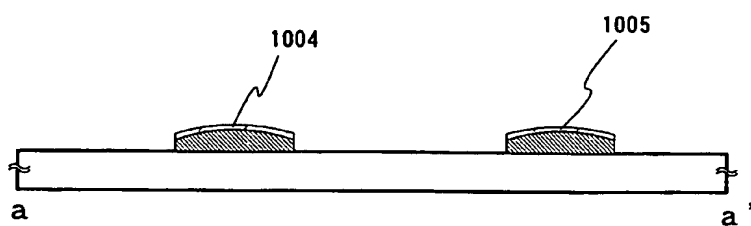
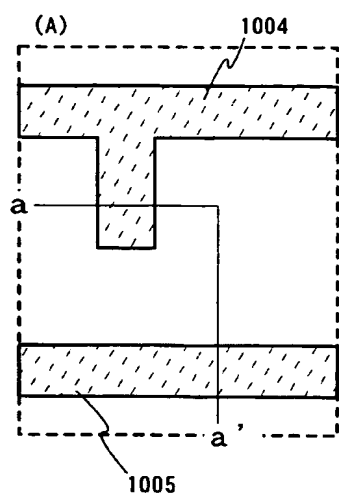
【図 9】



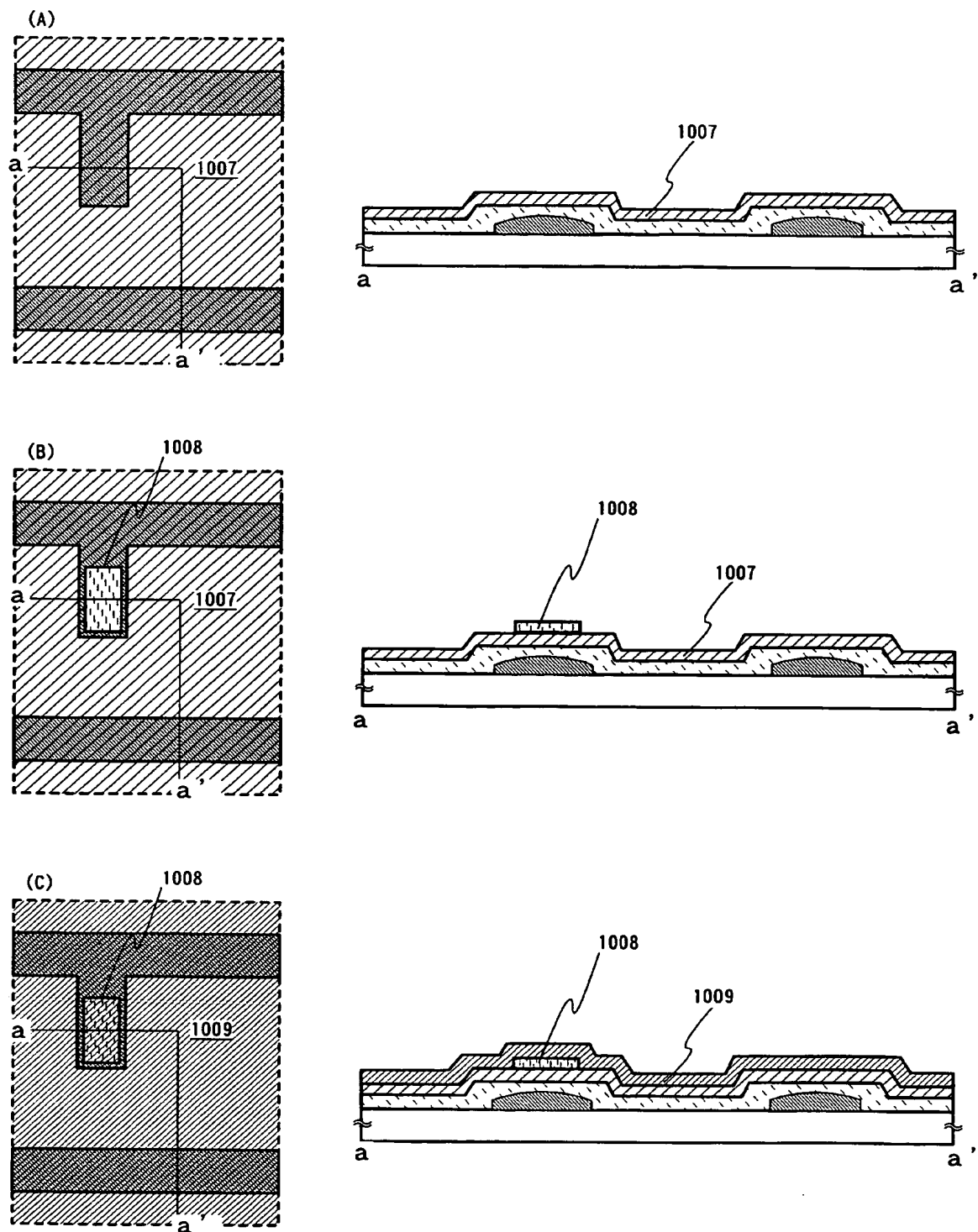
【図 10】



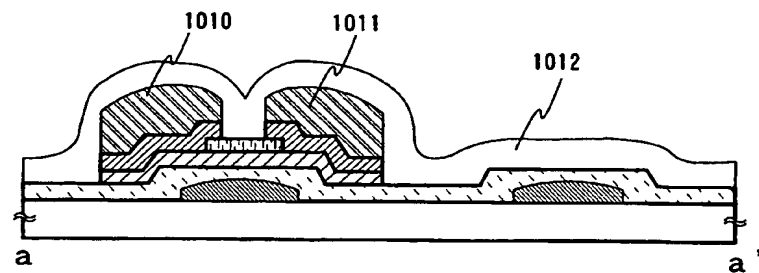
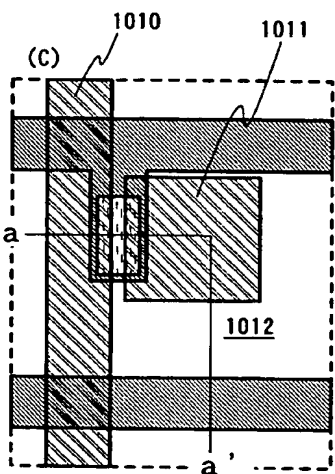
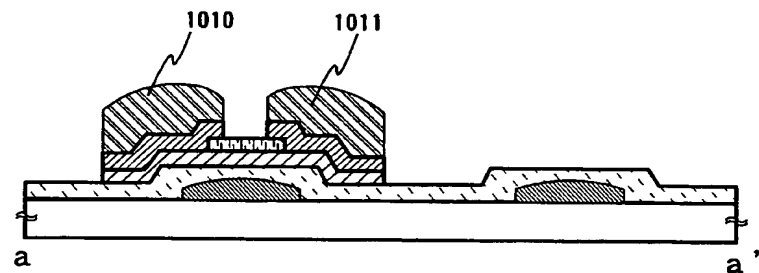
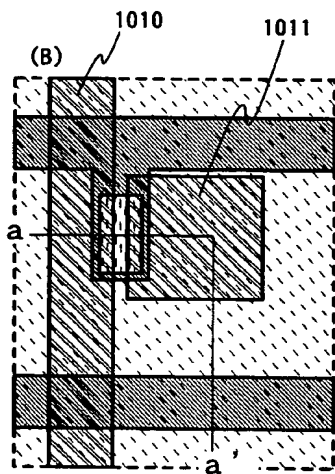
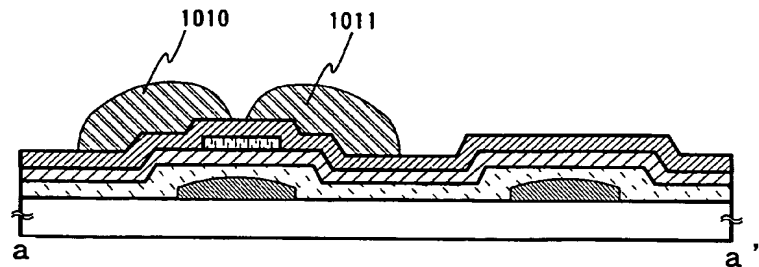
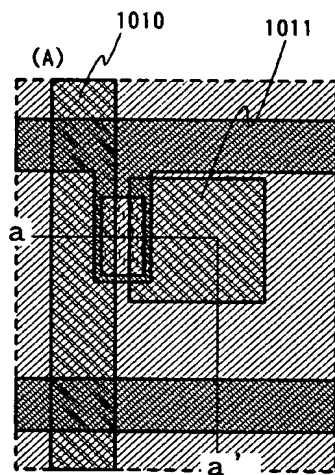
【図 11】



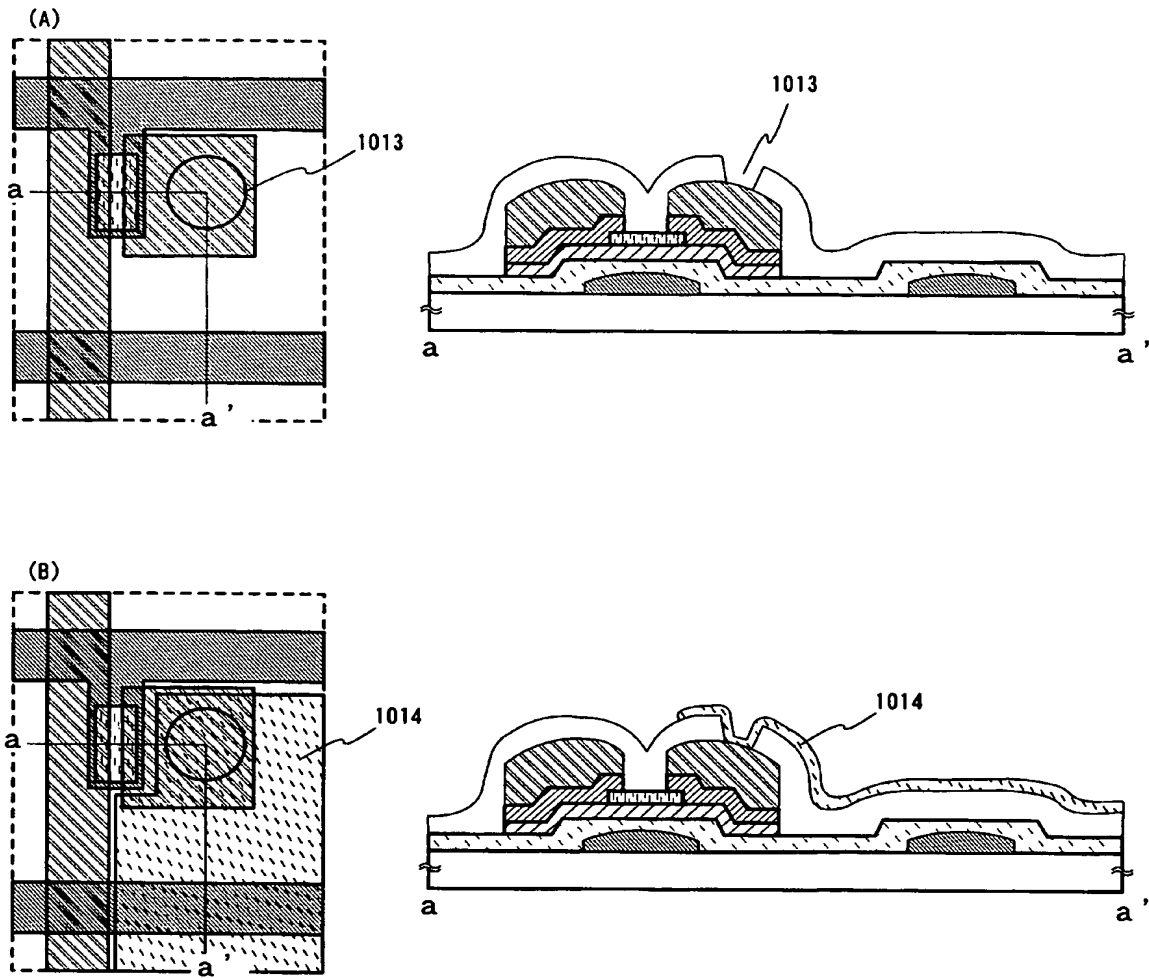
【図 12】



【図 13】

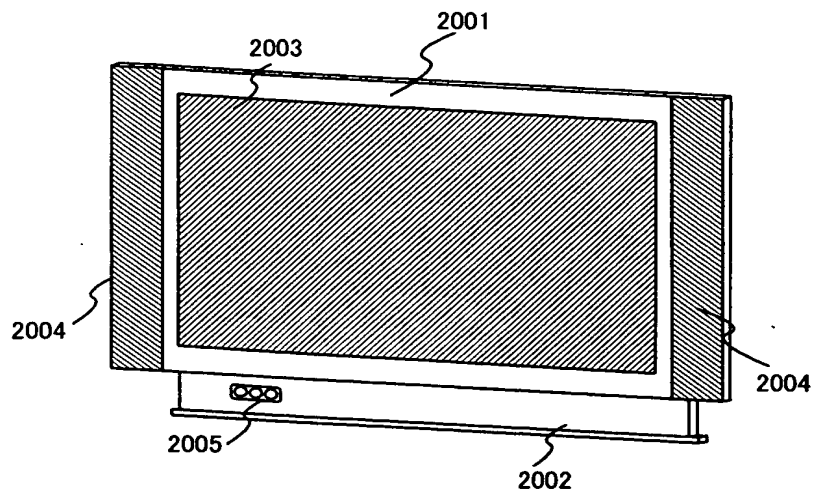


【図 14】

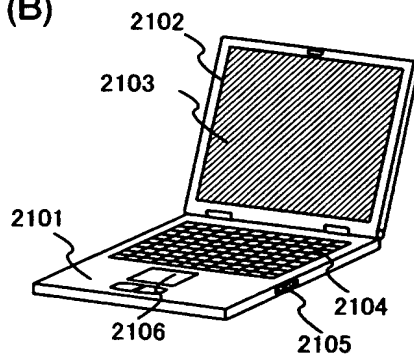


【図 15】

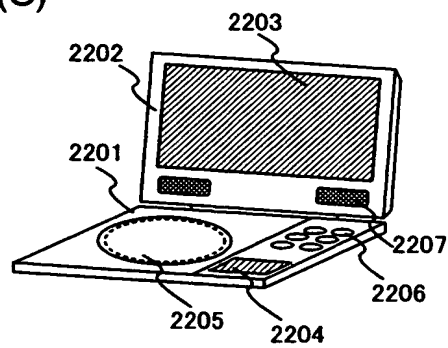
(A)



(B)



(C)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 表示装置の製造工程において使用する原材料の使用量および真空処理工程に係る手間を低減し、表示装置製造の低コスト化を実現する表示装置の作製方法について提案すること。

【解決手段】 本発明の表示装置の作製方法は、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する第1の液滴噴射装置を用いて、被処理膜上に導電性粒子を含有する液滴を噴射し、導電性膜を形成した後、複数の液滴噴射孔を配置した液滴噴射ヘッドを有する第2の液滴噴射装置を用いて前記導電性膜の上に局所的にレジストパターンを形成し、前記レジストパターンをマスクとして前記導電性膜をエッチングし、配線を形成することを特徴とする。

【選択図】 図1

特願 2 0 0 3 - 0 2 9 9 5 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 1 5 3 8 7 8]

1 . 変 更 年 月 日

1 9 9 0 年 8 月 1 7 日

[変 更 理 由]

新 規 登 録

住 所

神 奈 川 県 厚 木 市 長 谷 3 9 8 番 地

氏 名

株 式 会 社 半 導 体 エ ネ ル ギ ー 研 究 所